

利用課題番号 : F-13-WS-0073
利用形態 : 技術相談
利用課題名 (日本語) : MEMS デバイスの基板接合技術に関する基礎実験
Program Title (English) : Basic experiment of wafer bonding technology for MEMS
利用者名 (日本語) : 廣久保 望¹⁾
Username (English) : N. Hirokubo¹⁾
所属名 (日本語) : 1) セイコーエプソン株式会社
Affiliation (English) : 1) Seiko Epson Corporation

1. 概要 (Summary) :

企業の秘密上、応用デバイスについて今回は伏せておくが、我々は弱電用 MEMS デバイスのウェハレベルパッケージへの応用を目指した基板接合技術の開発を行っている、本研究では、各種表面処理方法及び荷重等の接合条件と接合状態の関係性を評価し、MEMS デバイスの基板接合に適した接合方法の方向性を示すことを目的とする。

対象ウェハの大きさは 4 インチで、200°C以下の低温接合を目指している。

この目的に対し、適用出来る MEMS デバイスの各種の接合技術に関していくつか説明して頂き、種々の接合条件の重要性について相談した。今後、実際のデバイスに応用していく予定である。

2. 実験 (Experimental) :

なし。

3. 結果と考察 (Results and Discussion) :

なし。

4. その他・特記事項 (Others) :

なし。

5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation) :

なし。

6. 関連特許 (Patent) :

なし。